

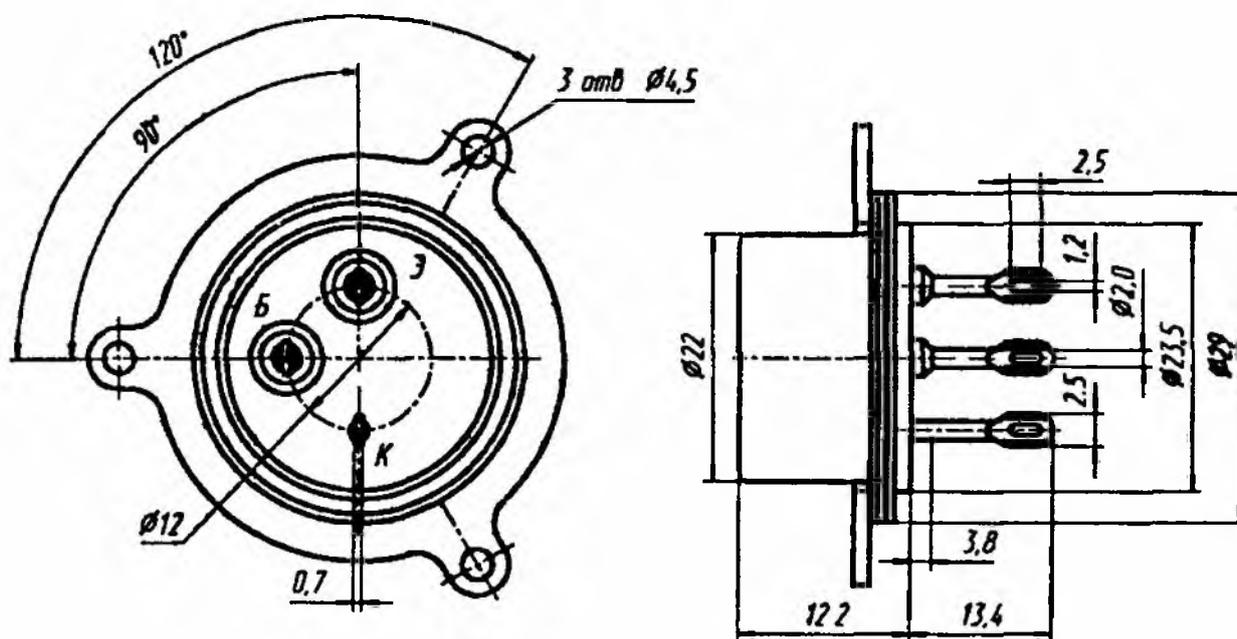
## 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В, ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры *p-n-p* переключательные. Предназначены для применения в импульсных устройствах, преобразователях и стабилизаторах тока и напряжения. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 28 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

*1Т806(А-В), ГТ806(А-Д)*



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ (на границе насыщения):

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В:

|   |          |
|---|----------|
| при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ ..... | 10...100 |
| при $T = +70\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 5\text{ А}$ .....  | 10...100 |
| при $T = -60\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ ..... | 10...150 |

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д:

|   |          |
|---|----------|
| при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ ..... | 10...100 |
| при $T = +55\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 5\text{ А}$ .....  | 10...200 |
| при $T = -55\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ ..... | 8...100  |

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КЭ} = 5\text{ В}$ ,  $I_K = 1\text{ А}$ ,

не менее ..... 10 МГц

Граничное напряжение при  $I_B = 3\text{ А}$ ,

$t_{и} < 50$  мкс,  $f = 20...50$  Гц, не менее:

|              |      |
|--------------|------|
| 1Т806А ..... | 40 В |
| 1Т806Б ..... | 65 В |
| 1Т806В ..... | 80 В |

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:

|  |       |
|--|-------|
| при $I_k = 20$ А, $I_b = 2$ А для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В ..... | 0,6 В |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| при $I_k = 15$ А, $I_b = 2$ А для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д ..... | 0,6 В |
|--|-------|

Напряжение насыщения база—эмиттер, не более:

|  |       |
|--|-------|
| при $I_k = 20$ А, $I_b = 2$ А для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В ..... | 0,8 В |
|--|-------|

|  |     |
|--|-----|
| при $I_k = 15$ А, $I_b = 2$ А для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д ..... | 1 В |
|--|-----|

Время выключения при  $U_{кз} = 45$  В,  $I_k = 5$  А,  $I_b = 0,25$  А, не более .....

30 мкс

Обратный ток коллектор—эмиттер при  $U_{бэ} = 1$  В,  $U_{кз} = 75$  В для 1Т806А,  $U_{кз} = 100$  В для 1Т806Б,  $U_{кз} = 120$  В для 1Т806В, не более:

$T = +25$  и  $-60$  °С .....

12 мА

$T = +70$  °С .....

25 мА

$T = +25$  °С,  $U_{кз} = U_{кз, макс}$  для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д.....

15 мА

Обратный ток эмиттера, не более:

при  $U_{бэ} = 2$  В для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....

5 мА

при  $U_{бэ} = 1,5$  В для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .....

8 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при  $U_{бэ} = 1$  В:

1Т806А, ГТ806А .....

75 В

1Т806Б, ГТ806Б .....

100 В

1Т806В, ГТ806В .....

120 В

ГТ806Г .....

50 В

ГТ806Д .....

140 В

Постоянное напряжение база—эмиттер:

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.....

2 В

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .....

1,5 В

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения:

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.....

20 А

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д   | 15 А                       |
| Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при $Q \geq 2$ , $t_{и} = 1000$ мкс, $K_{НАС} = 1$ для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В ..... | 25 А                       |
| Постоянный ток базы .....  | 3 А                        |
| Постоянно рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> :  |                            |
| с теплоотводом, $T_K \leq +25$ °С .....  | 30 Вт                      |
| без теплоотвода, $T \leq +25$ °С .....   | 2 Вт                       |
| Тепловое сопротивление переход—корпус .....  | 2 °С/Вт                    |
| Тепловое сопротивление переход—среда .....   | 30 °С/Вт                   |
| Температура <i>p-n</i> перехода .....  | +85 °С                     |
| Температура окружающей среды:  |                            |
| 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....   | -60... $T_K =$<br>= +70 °С |
| ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д.  | -55... $T_K =$<br>= +55 °С |

<sup>1</sup> При  $T_K > +25$  °С для транзисторов с теплоотводом

$$P_{K, \text{МАКС}} = (85 - T_K) / R_{T(p-k)}, \text{ Вт};$$

при  $T > +25$  °С для транзисторов без теплоотвода

$$P_{K, \text{МАКС}} = (85 - T) / R_{T(p-c)}, \text{ Вт}.$$

Не допускается отключение базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером. Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур.

Эксплуатация транзисторов в режимах за пределами областей максимальных режимов (в том числе с учетом процессов, происходящих при включении и выключении) запрещается. При работе в импульсном режиме при отсутствии открывающего импульса транзистор должен быть закрыт положительным смещением базы  $0,5 \text{ В} \leq U_{БЭ} \leq 2 \text{ В}$ .

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться первым.